

**Список публикаций официального оппонента, Фирсова Д.А.,
по теме диссертации Смирнова Д.С.**

1. D.A. Firsov, L.E. Vorobjev, V.Yu. Panevin, N.K. Fedosov, V.A. Shalygin, J.B. Samsonenko, A.A. Tonkikh, G.E. Cirlin, A. Andreev, N.V. Kryzhanovskaya, I.S. Tarasov, N.A. Pikhtin, V.M. Ustinov, S. Hanna, A. Seilmeier, F.H. Julien, N.D. Zakharov, P. Werner. Light absorption and photoluminescence in quantum dots and artificial molecules // Acta Physica Polonica A. – 2005. – Т. 107. – С. 158-162.
2. Л.Е. Воробьев, М.Я. Винниченко, Д.А. Фирсов, В.Л. Зерова, В.Ю. Паневин, А.Н. Софронов, П. Тхумронгсилапа, В.М. Устинов, А.Е. Жуков, А.П. Васильев, L. Shterengas, G. Kipshidze, T. Hosoda, G. Belenky. Разогрев носителей заряда в квантовых ямах при оптической и токовой инжекции электронно-дырочных пар // Физика и техника полупроводников. – 2010. – Т. 44. – №. 11 – С. 604-611.
3. B. Eichenberg, S. Dobmann, H. Wunderlich, A. Seilmeier, L.E. Vorobjev, D.A. Firsov, V. Panevin, A.A. Tonkikh. Intraband spectroscopy of excited quantum dot levels by measuring photoinduced currents // Physica E. – 2011. – Т. 43. – №. 6. – С. 1162-1165.
4. Л.Е. Воробьев, Д.А. Фирсов, В.А. Шалыгин, В.Ю. Паневин, А.Н. Софронов, А.И. Якимов, А.В. Двуреченский, А.А. Тонких, Р. Werner. Фотоиндущированное и равновесное поглощение света в квантовых точках Ge/Si // Физика и техника полупроводников – 2012.– Т. 46. – №. 12 – С. 1566-1570.
5. В.Ю. Паневин, А.Н. Софронов, Л.Е. Воробьев, Д.А. Фирсов, В.А. Шалыгин, М.Я. Винниченко, Р.М. Балагула, А.А. Тонких, Р. Werner, B. Fuhrman, G. Schmidt. Латеральная фотопроводимость структур с квантовыми точками Ge/Si // Физика и техника полупроводников. – 2013. – Т. 47. – №. 12. – С. 1599-1603.
6. A.N. Sofronov, L.E. Vorobjev, D.A. Firsov, V.Y. Panevin, R.M. Balagula, P. Werner, A.A. Tonkikh. Photoinduced mid-infrared intraband light absorption and photoconductivity in Ge/Si quantum dots // Superlattices and Microstructures – 2015. – Т. 87 – С. 53-57.
7. A.N. Sofronov, L.E. Vorobjev, D.A. Firsov, R.M. Balagula, A.A. Tonkikh. Temperature depopulation of the GeSi/Si quantum dots with non-equilibrium charge carriers // Superlattices and Microstructures – 2017. – Т. 107 – С. 228-233.